



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20071120000A

2009 年 3 月 11 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 品質保証部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

ハイパフォーマンスアナログ SOIC(14/16D)パッケージ一部製品 組立サイト追加のご案内

(認定済 88 製品からの変更対象除外 8 製品の連絡)

(第二版 PCN20071120000 2008 年 9 月 5 日発行、初版 PCN20071120000 2007 年 12 月 11 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	下記変更について、認定済88製品からの変更対象除外8製品の連絡になります。 ハイパフォーマンスアナログ SOIC(14/16D) パッケージ一部製品 組立サイト追加 現行：TI-Taiwanサイト 変更後：TI-Taiwanサイト及びTI-Mexicoサイト			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2008 年 10 月上旬の出荷より実施しています。			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について認定済88製品からの変更対象除外8製品の連絡になります。

弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) SOIC (14/16D) パッケージ部製品の組立サイトについて、現行 TI-Taiwan (TAI) サイトにて製造しておりますが、これに加え TI Mexico (FMX) での製造を追加し認定しました。この変更に伴い、下記のように若干の部材の変更がありますが、弊社他製造サイトにて量産に適用されているものです。尚、今回の変更で、製品についての互換性 (寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。また、出荷梱包部材につきましては、追加認定したサイトで現在使用しております部材の使用とさせていただきます。

変更内容	現行	変更後
製造サイト	TI-Taiwan (TAI)	TI-Taiwan (TAI) TI Mexico (FMX)
マウントコンパウンド	Hitachi EN4088Z	Hitachi EN4088Z Quantum QMI505MT

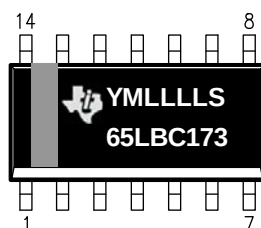
理由：供給能力の確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
□: 認定終了品		取消線 (右詰め): 変更対象除外品		
SN65LBC173D	SN65LVCP22DR	SN65LVDS348D	SN65LVD1348DR	SN75LBC180D
SN65LBC173DG4	SN65LVCP22DRG4	SN65LVDS348DG4	SN65LVD1348DRG4	SN75LBC180DG4
SN65LBC173DR	SN65LVCP23D	SN65LVDS348DR	SN65LVD1390D	SN75LBC180DR
SN65LBC173DRG4	SN65LVCP23DG4	SN65LVDS348DRG4	SN65LVD1390DG4	SN75LBC180DRG4
SN65LBC175D	SN65LVCP23DR	SN65LVDS390D	SN65LVD1390DR	SN75LVDS390D
SN65LBC175DG4	SN65LVCP23DRG4	SN65LVDS390DG4	SN65LVD1390DRG4	SN75LVDS390DG4
SN65LBC175DR	SN65LVDS048AD	SN65LVDS390DR	SN75LBC173D	SN75LVDS390DR
SN65LBC175DRG4	SN65LVDS048ADG4	SN65LVDS390DRG4	SN75LBC173DG4	SN75LVDS390DRG4
SN65LBC180AD	SN65LVDS048ADR	SN65LVDS391D	SN75LBC173DR	SN75LVDS391D
SN65LBC180ADG4	SN65LVDS048ADRG4	SN65LVDS391DG4	SN75LBC173DRG4	SN75LVDS391DG4
SN65LBC180ADR	SN65LVDS104D	SN65LVDS391DR	SN75LBC175D	SN75LVDS391DR
SN65LBC180ADRG4	SN65LVDS104DG4	SN65LVDS391DRG4	SN75LBC175DG4	SN75LVDS391DRG4
SN65LBC180D	SN65LVDS104DR	SN65LVD122D	SN75LBC175DR	SN75LVD1390D
SN65LBC180DG4	SN65LVDS104DRG4	SN65LVD122DG4	SN75LBC175DRG4	SN75LVD1390DG4
SN65LBC180DR	SN65LVDS105D	SN65LVD122DR	SN75LBC180AD	SN75LVD1390DR
SN65LBC180DRG4	SN65LVDS105DG4	SN65LVD122DRG4	SN75LBC180ADG4	SN75LVD1390DRG4
SN65LVCP22D	SN65LVDS105DR	SN65LVD1348D	SN75LBC180ADR	
SN65LVCP22DG4	SN65LVDS105DRG4	SN65LVD1348DG4	SN75LBC180ADRG4	

製品表示

製造サイト追加に伴い、製品表示の製造サイトを示すコード ("S" の部分) が、"T" (TAI: TI-Taiwan) に加え、"M" (FMX: TI Mexico) となります。



YM = Year/Month Code
 LLLL = Assy Lot
 S = Assy Site Code
 M : Mexico
 T : Taiwan

図 1 製品表示の例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信賴性試驗結果					
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2008 年 8 月 7 日	
信賴性試驗 — 試料構成詳細					
Device ID:	A	B	C	D	
Qual Device:	SN65LVCP23D	SN65LVDT122D	SN65LBC180AD	SN65LVDS048AD	
Die Rev/Size(mils):	A / 80 x 135	- / 80 x 92	A / 77 x 86	A / 83 x 83	
Wafer Fab Site:	FFAB	TID	-	-	
Fab Process:	RFBiCMOS1	RFBiCMOS-1	-	-	
Metal1-2:	TiW/AlSiCu.5%	TiW/AlSiCu.5%	-	-	
Passivation:	10KA CN	10KA CN	-	-	
Assembly Site:	FMX	FMX	FMX	FMX	
Package/Pin:	D / 16	D / 16	D / 14	D / 16	
Mount Compound:	QMI 505MT	QMI 505MT	QMI 505MT	QMI 505MT	
Mold Compound:	GR825-73B	GR825-73B	GR825-73B	GR825-73B	
Bond Wire:	T1-0.95 MIL Au	T1-0.95 MIL Au	T1-0.95 MIL Au	T1-0.95 MIL Au	
L/F Composition/Finish:	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	
Flammability Rating:	Class UL94-V0	Class UL94-V0	Class UL94-V0	Class UL94-V0	
Moisture Sensitivity Level:	JEDEC L1-260C	JEDEC L1-260C	JEDEC L1-260C	JEDEC L1-260C	
信賴性試驗結果					
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails			
		A	B	C	D
X-Ray	Top Only	5/0	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification	Per MFG site spec	Approved	Approved	Approved	Approved
Wire Bond Pull	Per MFG site spec	76/0	76/0	76/0	76/0
Ball Bond Shear	Per MFG site spec	76/0	76/0	76/0	76/0

信頼性試験結果

信頼性試験結果						
信頼性試験期間		開始	—	終了	2007 年 3 月 15 日	
信頼性試験 — 試料構成詳細						
Device ID:	A	B	C	D	E	
Qualification Device:	CCBTS3384 DBQR	SN75976A1 DL	TL598C D	TLC320AD50I DW	TPS2201I DB	
Die Rev/Size(mils):	E / 61 x 43	B / 121 x 300	F / 80 x 140	- / 146 x 181	B / 142 x 204	
Wafer Fab Site:	SFAB	HIJ	SFAB	DFAB	DLN	
Technology:	CMOS	LinBiCMOS	Bipolar	CMOS	LinBiCMOS	
Fab Process:	EPIC-1ZS	LBC3S	Std Linear	EPIC-1ZS	LBC2	
Metal1:	TiW/AlCu2%	TiW/AlSiCu.5%	TiW/AlCu2%	AlCu2%	TiW/AlSiCu.5%	
Metal2:	TiW/AlCu2%	TiW/AlSiCu.5%	None	AlCu2%	TiW/AlSiCu.5%	
Passivation:	10KACN	10KACN	10KACN	12KACN	10KACN	
Assembly Site:	MLA	MLA	MEX	TAI	MLA	
Package/ Pin:	DBQ / 24	DL / 56	D / 16	DW / 28	DB / 30	
Mold Compound:	GR825-73B	GR825-73B	GR825-73B	GR825-73B	GR825-73B	
Mount Compound:	HIT EN-4088Z	HIT EN-4088Z	QMI 505MT	HIT EN-4088Z	HIT EN-4088Z	
Bond:	TS-0.95 Au	TS-0.95 Au	TS-1.15 Au	TS-0.95 Au	TS-2.0 Au	
L/F Composition/Finish:	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	Cu / NiPdAu	
JEDEC Moist Sens Level:	L2-260C	L2-260C	L1-260C	L1-260C	L1-260C	
Flammability Rating:	UL 94 V 0	UL 94 V 0	UL 94 V 0	UL 94 V 0	UL 94 V 0	
信頼性試験結果						
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails				
		A	B	C	D	E
** Autoclave	121C, 240 hours	77/0	77/0	67/0	77/0	77/0
** Temp Cycle	-65/150C, 1000 cycles	77/0	77/0	70/0	77/0	77/0
** Thermal Shock	-65/150C, 1000 cycles	77/0	77/0	74/0	77/0	77/0
Moisture Sensitivity	JEDEC	22/0	22/0	12/0	12/0	22/0
Manufacturability	Per Mfg site spec.	Approved	Approved	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning Proper Sequence by Device						